高効率太陽熱吸収技術に関する研究開発

早川 亮・芦澤 里樹・石田 正文・鈴木 大介・吉村 千秋*1

Research and Development of High Efficient Solar Absorbing Technology

Ryo HAYAKAWA, Satoki ASHIZAWA, Masahumi ISHIDA, Daisuke SUZUKI and Chiaki YOSHIMURA^{*1}

要 約

高効率太陽熱選択吸収膜の開発を目的として, 陽極酸化法を用いてアルマイト膜を形成すると共に, 作製したアル マイト膜を染料への浸漬処理によって黒色の染色を行った. 陽極酸化の電解条件は, 電解液を15%硫酸, 電解槽電 圧を定電圧法で10V, 浴温度を20℃, 電解時間は5~120分間とした. その結果, アルマイト膜は約29.0μmまで形 成された. また, 染色性をL*a*b*表色系により評価した結果, アルマイト膜が16μm以上の厚さに達すると染色され た色調に変化は見られなかった.

1. 緒 言

近年,地球温暖化などグローバルヒーティングの問題 が顕在化しており¹⁾,このような危機的状況から脱する には,現在の化石燃料主体の社会を抜本的に改革する必 要がある.そのため太陽エネルギーの利用技術はCO₂削 減の面において重要であり,脱化石燃料に向けた再生可 能なエネルギー開発という点でも大きな役割が期待され ている.実際,アメリカやスペインなどのサンベルトに おいて大規模な太陽熱発電の商業プラントの運転が開始 されており,太陽熱発電技術は電力市場に参入できると ころにまで近づいて来ている²⁾.

しかし実用化する際には、光エネルギーを高効率に吸 収すると共に、吸収した熱の放射を高度に抑制すること が重要である.このように高効率な太陽熱利用を行うた めには、可視~近赤外の波長で高い吸収率を持ち、赤外 域の波長で低い放射率を持つ選択吸収膜が必要となる.

これらの特性を備えた集光システムは、これまでに種 々の材料で開発されている.しかし、高効率な選択吸収 膜の製法は真空技術を応用したスパッタリング法を用い ており、製造設備がきわめて高価である.

そのため選択吸収膜の製法は,より安価な製造プロセ スで実現することが課題となっている.

そこで本研究では、陽極酸化法を用いたアルマイト膜 形成を中心に、高効率で低コストな選択吸収膜の開発を 行うことを目的とした.また、アルマイト膜の染色方法 には、各種方法の中で最も低コストな方法である、染料 を用いた浸漬処理に着目し、アルマイト膜の膜厚と染色

*1 山梨県富士工業技術センター

性の関係について調べた.

2. 実験方法

2-1 試料および陽極酸化によるアルマイト膜作製 アルマイト膜の作製には、希硫酸中で処理を行う硫酸 陽極酸化を用いた.この方法はコストが安く、皮膜が無 色透明であり、着色仕上げに向いていることから、現在 の陽極酸化の主流になっている³⁾.

試料には、100×10×1 mm,純度99%の純アルミニ ウム板(㈱ニラコ製)を用いた.前処理として、アセト ン中での超音波洗浄により脱脂を行った.陽極酸化処理 には一般的に用いられている条件を適用し、電解液を 15%硫酸、電解槽電圧を定電圧法で10V,浴温度を20 ℃とした.その際、陰極には陽極と同質の脱脂処理を施 したアルミニウム板(100×50×1 mm)を用い、電極 間距離を100mmとして電解時間5~120分で処理を行っ た.なお、電解処理中は電解液の撹拌を十分に行った.

2-2 皮膜形成の確認

2-2-1 XPSによる表面分析

陽極酸化後,アルマイト膜の形成を確認するためにX 線光電子分光法(XPS,日本電子(株製,JPS-9010TR) を用いて,表面分析を行った.光電子スペクトルの解 析にはHandbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy⁴⁾ に記載されている値を用いた.

まず,XPSによる表面分析を行う前に,試料表面の 清浄化を目的として,熱陰極電子衝撃型(カウフマン型) イオン銃を用いてArイオンによるエッチングを行った. その際の条件は,Arの導入圧力を3×10⁻²Pa,加速電 圧を500V,加速電流を8.6mA,エッチング時間を4 sec とした.

試料表面の清浄化後にXPSによる表面分析を行った. X線源にはAlK α 線(1486.6eV)を用い,分析範囲は ϕ 8.0mmとした.また,試料のチャージアップ防止のた めに中和銃を用いた.その際,加速電圧を3V,加速電 流を4mAとした.

光電子スペクトルの測定は,エネルギー範囲0~ 1300eVのワイドレンジを測定した後,ナローレンジと してAl 2p電子, O 1s電子およびC 1s電子を測定した.

2-2-2 膜厚測定

陽極酸化後,形成されたアルマイト膜の膜厚を測定す るために,金属顕微鏡(㈱ニコン製,EPI PHOTO)を 用いて断面観察を行った.

試験片は、各条件によりアルマイト膜を形成させた試料から10×10mmのサイズに切り出し、エポキシ樹脂中に埋没後、エメリー紙および粒径0.3µmのアルミナ粉末により断面を鏡面状態に研磨した.これを金属顕微鏡により断面観察し、皮膜の厚さを実測した.

2-3 染色および封孔処理

作製したアルマイト膜への染色として,染料による浸 漬処理を行った.この処理は,染色方法の中で最も低コ ストであり,染色する色の制約が無いという利点がある ことから染色方法として選択した.染色する色は,色立 体において色の違いが最も大きく表れる黒色とした.色 の濃淡は染料濃度の影響を受けることから,常に一定の 濃度を得る必要がある.そのため,染料にはプリンタ用 として市販されている黒色インク(エプソンプリンタ用 黒インク,エレコム㈱製,THE-50BK3)を用いた.

浸漬処理には、各条件によりアルマイト膜を形成させた試料から10×10mmのサイズに切り出した試験片を用いた.これを60℃に加熱した染料中で10分間保持した.その後、封孔処理として沸騰した純水中で30分間保持した.

2-4 皮膜の評価

染色した試料の染色性については、色調の変化を基に して評価を行った。色調変化は、測色計(クラボウ㈱製、 COLOR-7e²)を用いて測定し、L*a*b*表色系で表した。 さらに、陽極酸化処理を施していない試験片を未染色の 基準試料として用い、染色試料とのL*a*b*表色系の差か ら各試料の色差 Δ E*abを算出した。

3. 結果および考察

3-1 XPSによる表面分析

陽極酸化処理を行う前の試料と5分間の処理を行った試料の表面をXPSにより分析し、光電子スペクトルを測定した。

ワイドレンジおよびC 1s電子について, 試料表面の清 浄化のために行ったエッチングの前後における光電子ス ペクトルの変化を, 陽極酸化処理前の試料を例として, 図1および図2にそれぞれ示す.



図1 陽極酸化処理(5 min)後の試料における光電子スペ クトル(ワイド)のエッチングに伴う変化



図2 陽極酸化処理(5min)後の試料におけるC1s光電子 スペクトルのエッチングに伴う変化

4 秒間のエッチングを行った結果,図1の光電子ス ペクトルにおいてC1s光電子スペクトルの強度は減少 し,それに伴いAl2pおよびO1s光電子のスペクトルの 強度が若干増大した.図2のC1s光電子スペクトルの ピーク位置が284.2eVであることから,この炭素はグラ ファイトであり表面の汚れであることが分かる.

エッチング後,このピークが消失したことから,4秒 間のエッチングによって試料表面が十分に清浄化された ことが確認された.

5 分間の陽極酸化処理を行った試料におけるAl 2pお よび0 1s光電子スペクトルを図3および4に示す. Al 2p光電子スペクトルにおいて, ピークは酸化物状 態であるAl₂O₃を示す74.1eVに現れた. O 1s光電子スペ クトルにおいては, 530.9eVにピークが現れており, こ のピーク位置は酸素がAl₂O₃の結合状態にあることを示 している. さらに, Al 2pとO 1sのピーク面積から両者 の割合を求めた結果, Al:Oは40.6:59.4であり, これ はAl₂O₃の組成比とほぼ同じである. これらのことから, 陽極酸化処理によって, 試料表面にアルマイト膜が形成 されたことが分かった.



図3 陽極酸化処理(5 min)に伴うAl 2p光電子スペクトルの変化



図4 陽極酸化処理(5 min)に伴うO1s光電子スペクトルの変化

3-2 膜厚測定

陽極酸化した試料表面の断面写真を処理時間15,60 および120分間の場合を例として図5に示す.

この断面から、アルマイト膜が電解処理時間の増加に 伴い成長しているのが分かる.これらの試料における被 膜の厚さを測定した結果を図6に示す.

膜厚は電解時間に比例して増大しており、120分間の 処理において膜厚は約29.0μmまで成長した. なお、今 回の処理時間範囲における成膜速度は0.24μm/minであ ることが分かった.





図 5 陽極酸化処理を行った試料の断面観察写真 処理時間: (a) 15min, (b) 60min, (c) 120min



3-3 皮膜の色調評価

アルマイト膜の染色性の評価基準として適用した皮膜 の色調については、L*a*b*表色系で表示する方法によっ て定量的に検討した.図7にL*a*b*表色系の立体図を 示す.



この図に示されるように、この表色系におけるL*は 明度, a*およびb*は原点を無彩色としたときの色相を表 しており、それらの値の絶対値が大きくなるに従って、 より鮮やかな色調となることを示している.しかし、本 研究では黒色に染色した試料の色調の変化から染色性の 評価を行っている.そのため、L*、a*、b*の絶対値および、 これらの値から次式で表される色差ΔE*abの値が小さ くなるほど染色性に優れていると考えられる.

 $\Delta E^* ab = ((\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2)^{-1/2}$

それぞれの試料において,この表色系により求めた明度L*および色座標値a*,b*をプロットした結果を図8に示す.

電解時間が15分までの試料においてa*およびb*の絶対





値は小さく緑ー青系色の傾向を示しているが、L*値が 50以上であることから、これらの試料はほとんど染色 されておらず、染色性が悪いことが分かる.45分の電 解処理を行った試料では、色の傾向が赤-青系色に変化 すると共に、a*およびb*の絶対値は急激に増大している ことから、染料への浸漬による染色の効果が現れ始めて いることが分かる.L*値も約20であり、より黒に近い 濃い色に染色されてきていることが分かる.また、染色 が可能であることから、多孔質皮膜の構造を持ったアル マイト皮膜が形成されていることが確認された.

電解時間が60分以上の試料においてはa*およびb*の絶 対値は再び急激に減少していき、その値は約1であり無 彩色を示す0に近づいた.また、L*値も約3であり完 全な黒色を示す0に近づくと共に、60から120分ではほ とんど変化が見られなかった.これらのことから、60 分以上の電解処理では染色性に与える影響が小さくなる ことが分かった.

図9に電解時間に伴う皮膜の膜厚および色差変化を 示す. 60分までの電解において、色差ΔE*abは処理時 間の増大に伴い増加した.しかし、60分以上の電解処 理を行った試料において、ΔE*abの値に変化は見られ なかった.

一方, 膜厚は先に述べたように電解時間と比例して増 大している. なお60分間の電解処理によって形成され た皮膜の厚さは約16µmであった. これらのことから, 染料への浸漬によって着色する場合, 15~20µm程度の アルマイト膜が形成されていれば十分な染色性が得られ ることが分かった.

4. 結 言

陽極酸化法を用いたアルマイト膜形成を中心に,高効 率で低コストな選択吸収膜の開発を行うことを目的とし て,アルマイト膜の形成と染料による浸漬処理による染 色を行うとともに,断面観察による膜厚測定および測色 計を用いて求めたL*a*b*表色系の値から,アルマイト膜の膜厚と染色性の関係について定量的に評価した.その結果,以下の知見が得られた.

- (1) 硫酸濃度を15%, 電解電圧を定電圧10V, 電解浴 温度を20℃とした条件において,純アルミ試料に 対して5~120分間までの陽極酸化処理を行った 結果,いずれの試料においてもアルマイト膜が形 成された.皮膜の厚さは処理時間の増加に比例し て増大していき,120分間の処理における膜厚は 29.0 µm, 成膜速度は0.24 µm/minであった.
- (2) 染料への浸漬処理によって黒色に染色した試料におけるL*a*b*表色系を求めた結果,電解処理時間が45分間の試料においてa*およびb*の絶対値が急激に増大し,60分間以上の試料では再び急激に減少した. また,60分間以上の試料ではL*値は0に近づいた.
- (3) 電解処理時間に比例して皮膜の厚さは増大しているのに対して、ΔE*abは電解処理時間が60分間以上の試料において一定となり、それ以上の増加は見られなかった.なお、60分間の電解処理によって形成された皮膜の厚さは約16μmであった.

以上の結果から、陽極酸化によって形成されたアルマ イト膜を染料への浸漬によって染色する場合、十分な染 色性を得るためには、膜厚が約15~20µmのアルマイト 膜が必要であると共に、それ以上の膜厚は染色性に大き な影響を与えないことが分かった.

参考文献

- 2)玉浦 裕:太陽エネルギー 有効利用最前線, p.3 (2008)
- 3)山口 裕: 軽金属, Vol.59, No.4, p.204 (2009)
- 4) C. D. Wagner, W. M. Riggs, L. E. Davis and J. F. Moulder : Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy (Ed. G. E. Muilenberg), Perkin-Elmer Corporation, Physical Electronics Division, Eden Prairie, Minn. USA (1979)